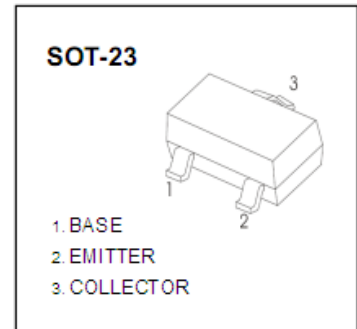


**2SC1623 ( NPN )****特点/Features :**

- 1、 $h_{FE}$  高,  $h_{FE}=200$ (TYP)  $V_{CE}=6V, I_C=1mA$ ;
- 2、高电压,  $V_{CEO}=50V$ ;

**用途/Applications :**

用于一般音频放大, 与 2SA812 互补。

**极限参数/Absolute maximum ratings( $T_a=25^{\circ}C$ )**

参数/Parameter	符号/ Symbol	数值/Value	单位/Unit
集电极-基极电压/Collector-Base Voltage	$V_{CBO}$	60	V
集电极-发射极电压/Collector-Emitter Voltage	$V_{CEO}$	50	V
发射极-基极电压/Emitter-Base Voltage	$V_{EBO}$	5	V
集电极连续电流/Collector Current Continuous	$I_C$	0.1	A
集电极耗散功率/Collector Power Dissipation	$P_C$	0.2	W
结温/Junction Temperature	$T_j$	150	$^{\circ}C$
储存温度/Storage Temperature	$T_{stg}$	-55~150	$^{\circ}C$

**电性能参数/Electrical characteristics ( $T_a=25^{\circ}C$ )**

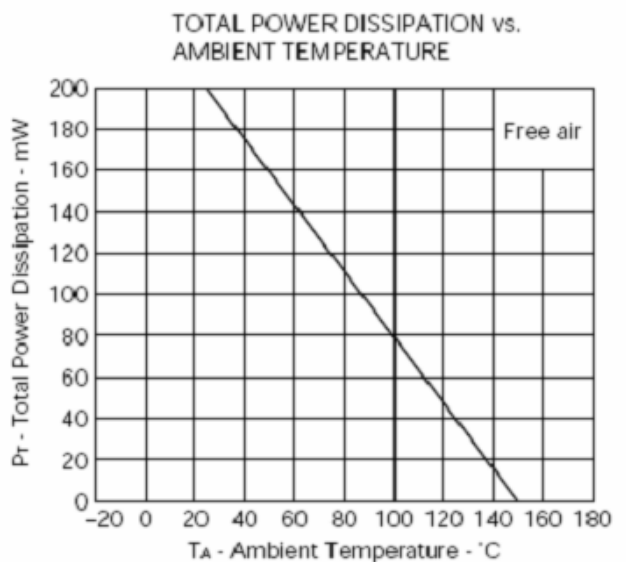
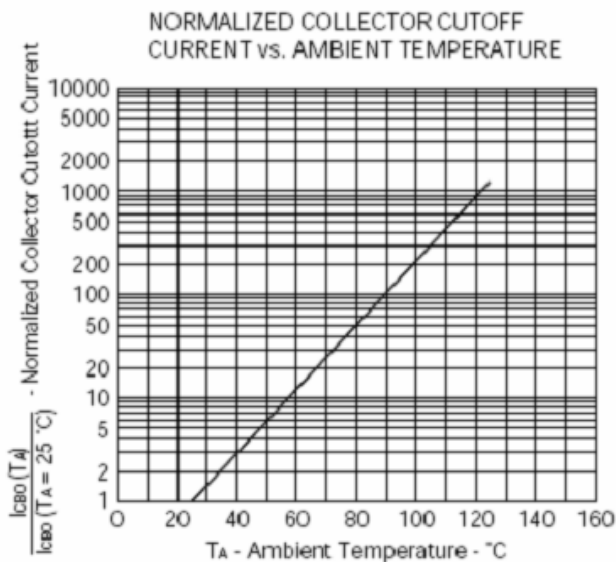
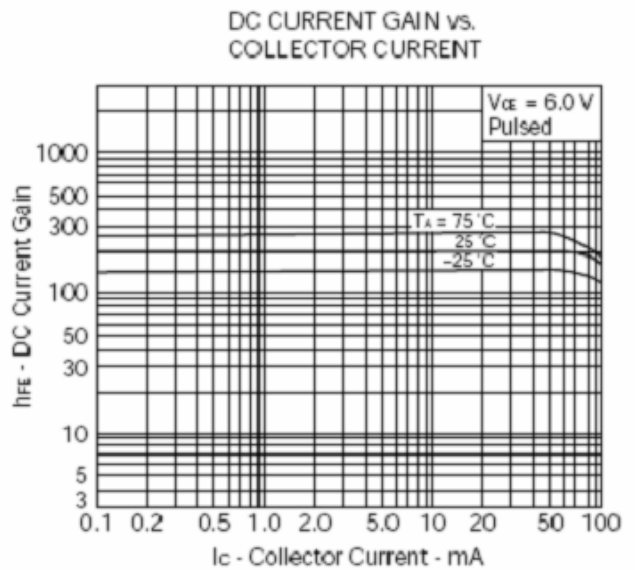
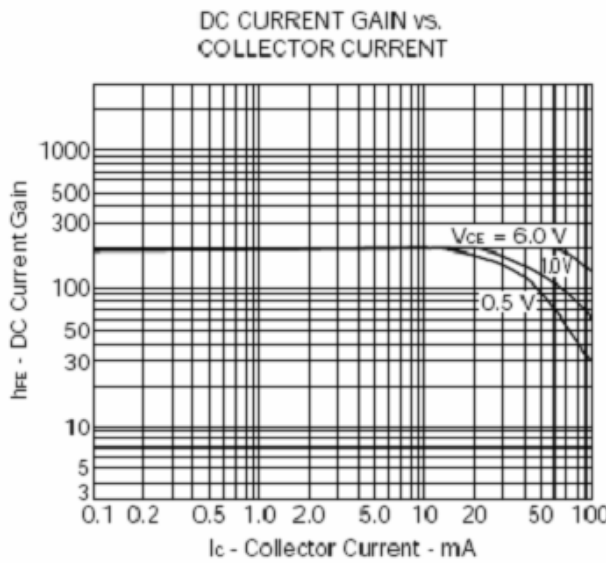
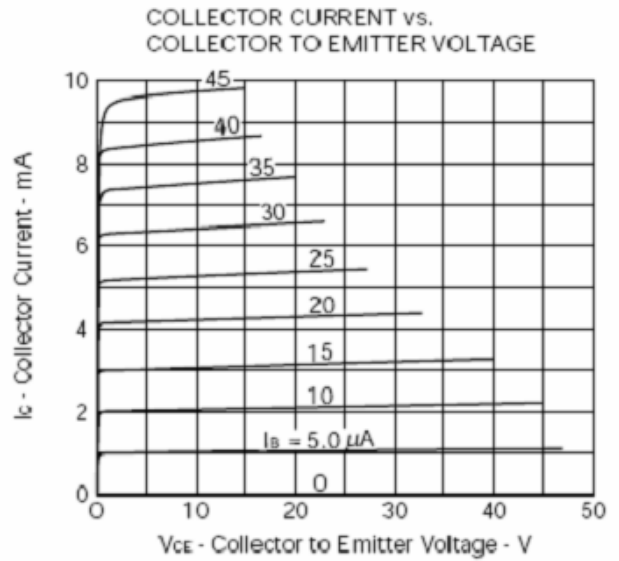
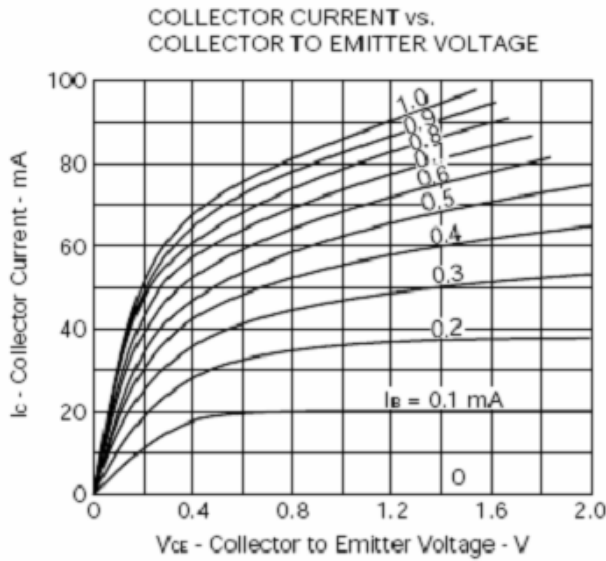
参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
集电极-基极击穿电压	$V_{BR(CBO)}$	$I_C=100\mu A, I_E=0$	60			V
集电极-发射极击穿电压	$V_{BR(CEO)}$	$I_C=1mA, I_B=0$	50			V
发射极-基极击穿电压	$V_{BR(EBO)}$	$I_E=100\mu A, I_C=0$	5			V
集电极截止电流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=60V, I_E=0$			0.1	$\mu A$
发射极截止电流	$I_{EBO}$	$V_{EB}=5V, I_C=0$			0.1	$\mu A$
直流电流增益	$h_{FE}$	$V_{CE}=6V, I_C=1mA$	90	200	600	
集电极-发射极饱和压降	$V_{CE(sat)}$	$I_C=100mA, I_B=10mA$			0.3	V
基极-发射极饱和压降	$V_{BE(sat)}$	$I_C=100mA, I_B=5mA$			1	V
特征频率	$f_T$	$V_{CE}=6V, I_C=10mA$		250		MHz

**印章/Marking &  $h_{FE}$  分档/Classification of  $h_{FE}$** 

范围/Range	90~180	135~270	200~400	300~600
印章/Marking	L4	L5	L6	L7



### 典型特性曲线图/Typical Characteristics





**SOT-23 封装半导体晶体管/SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors**

